

PSA-09 ポスター発表 一覧

番号	題目	発表者	所属
P01	半球型電子分光器を搭載したオージェ電子分光装置のジオメトリ特性と傾斜ホルダーを利用した超高深さ分解能オージェ深さ方向分析	○荻原俊弥、永富隆清、田沼繁夫	物質・材料研究機構、大阪大学
P02	AESによる絶縁物試料の分析手法	○田中章泰、堤建一	日本電子
P03	実験室系硬X線光電子分光分析装置の開発	○岩井秀夫、小島雅明、山瑞拓路、田中彰博、鈴木峰晴、池永英司、松田博之、大門寛、田沼繁夫、小林啓介	物質・材料研究機構、アルバック・ファイ、高輝度光科学研究センター、奈良先端科学技術大学院大学
P04	マルチアノードXPSによるSiO粉末試料の解析	○當麻 肇	株式会社日産アーク
P05	各種汎用ポリマーのC60+イオンエッチング速度	○山脇 健太郎、野本 裕香	凸版印刷(株)品質保証部
P06	有機材料のTOF-SIMSデプスプロファイリングにおけるC60イオンの入射角依存性	飯田真一、○宮山卓也、眞田則明、鈴木峰晴	アルバック・ファイ株式会社
P07	帯電液滴衝撃(EDI)/SIMSによる金属酸化膜の深さ方向分析	○境悠治、飯島善時、平岡賢三	山梨大学、日本電子
P08	帯電液滴衝撃(EDI)-SIMSを用いたポリカーボネート(PC)の深さ方向分析	○向 宗一郎、境 悠治、平岡 賢三	山梨大学
P09	帯電液滴エッチング法を用いたポリイミド、ポリ塩化ビニルフィルムのXPS深さ方向分析	○飯島 善時、境 悠治、平岡 賢三	日本電子(株)、山梨大学
P10	ToF-SIMS GW 活動報告 ラウンドロビンテスト08の結果	○伊藤 博人、ToF-SIMS WG	コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社
P11	ToF-SIMS分析における質量精度の向上を目的としたラウンドロビンテスト09の案内	○阿部芳巳、ToF-SIMS WG	三菱化学科学技術研究センター
P12	ファラデーカップの特性も単純ではない	○後藤敬典、黒河明、山内幸彦	産総研・中部センター、産総研・つくばセンター
P13	絶縁体の二次電子収率測定(1) パルス一次電子ビームの発生	有馬 智幸、栄 宏之、○宮川 拓也、井上 雅彦	摂南大学
P14	パルスイオン照射を用いたMgO薄膜のイオン誘起二次電子収率測定 [I] -膜厚50 nmのMgO薄膜のイオン誘起二次電子収率-	○村澤裕子、山内郁馬、吉野恭平、永富隆清、高井義造、森田幸弘、西谷幹彦、北川雅俊	大阪大学、パナソニック株式会社
P15	パルスイオン照射を用いたMgO薄膜のイオン誘起二次電子収率測定 [II] -膜厚50及び200 nmのMgO薄膜-	○永富隆清、山内郁馬、村澤裕子、吉野恭平、高井義造、森田幸弘、西谷幹彦、北川雅俊	大阪大学、パナソニック株式会社
P16	深さ分析プロファイルの深さ分解能、界面幅、界面位置はどうやって決めるの? [I] -ISOにおける定義、実用上の課題、標準化に向けての取り組み-	○永富隆清、荻原俊弥、田沼繁夫	大阪大学、物質・材料研究機構
P17	プロジェクト報告「スペクトル強度分散評価ラウンドロビンテスト:XPS」- 第一報	○福島 整、ノイズ分散評価ラウンドロビングループ	(独)物材機構
P18	ウスタイトを構成する鉄と炭素の存在比による炭素との反応性の変化	○石川信博、荻原俊弥、原田嵩弘、稲見隆	物質・材料研究機構
P19	油圧作動油により生成した潤滑膜の分析	○今野聡一郎、小西友弘、岩波陸修、小西正三郎	新日本石油(株) 研究開発本部 中央技術研究所
P20	AESによるステンレス鋼(SUS304、SUS3156)表面自然酸化膜の解析	○瀬下洋平 荻谷義治 木村隆	芝浦工業大学大学院 芝浦工業大学 物質・材料研究機構
P21	低速電子線誘起反応とトンネル反応により合成した炭素薄膜の表面分析	○森田直樹、伊東佑将、胡雪氷、土屋新平、渡辺陵、佐藤哲也、山本千綾、有元圭介、山中淳二、中川清和	クリーンエネルギー研究センター、ものづくり教育実践センター、クリスタル科学研究センター、山梨大学
P22	液相析出法とマイクロ波放電プラズマ加熱法により合成した酸化チタンの表面分析	○本郷健太、荒井哲司、佐藤哲也、中川清和	山梨大学クリーンエネルギー研究センター、山梨大学クリスタル科学研究センター
P23	コアシェル構造を持つAg-ジアセチレン ナノ粒子の硬X線光電子分光およびX線吸収スペクトル解析	○吉川英樹、木村昌弘、増原陽人、田沼繁夫、中西八郎、及川英俊	物質・材料研究機構、東北大学
P24	Kr+イオンビーム照射によるキトサンフィルム改質およびその表面解析	○篠宮 弘行、高橋 克宗、遠藤 一央、鈴木 嘉昭、矢島 博文、田村 溪一郎、井田 朋智	東京理科大学、理化学研究所 人工臓器材料研究チーム、金沢大学大学院 自然科学研究科
P25	モンテカルロ計算および量子力学的散乱理論によるCuOおよびSiO2の放出深さ分布関数の計算	○篠塚寛志、吉川英樹、田沼繁夫、藤川高志	物質・材料研究機構、千葉大学大学院
P26	量子化学計算による強誘電性PVDFフィルムの電子状態	○伊藤哲、遠藤一央、古川猛夫、矢島博文	東京理科大学 総合化学研究科及び界面科学研究センター